

## Список литературы

- [1] Иванов В.Ю., Пустоваров В.А., Горбунов С.В., Кружалов А.В. ФТТ **36**, 9, 2634 (1994).
- [2] Gorbunov S.V., Kudyakov S.V., Shulgin B.V., Yakovlev V.Yu. Abstracts of VII Europhys. Conf. on Defects in Insulating Materials EURODIM'94. Lyon (1994). P. 79.
- [3] Горбунов С.В., Яковлев В.Ю., Иванов В.Ю., Кружалов А.В. ФТТ **32**, 10, 2942 (1990).
- [4] Маслов В.А., Рылов Г.М., Мазуренко В.Г. и др. Расширенные тез. VI Междунар. конф. по росту кристаллов. М. (1980). Т. 3. С. 268.
- [5] Гриценко Б.П., Яковлев В.Ю., Лях Г.Д., Сафонов Ю.Н. Тез. Всесоюз. конф. по метрологии быстропротекающих процессов. М. (1978). С. 61.
- [6] Кузнецов А.И., Намозов Б.Р., Мюрк В.В. ФТТ **27**, 10, 3030 (1985).
- [7] Eshita T., Tanimura K., Itoh N., Nishimura H. J. Phys. Soc. Jpn. **54**, 11, 4418 (1985).
- [8] Ohata T., Hayashi T., Koshino S. J. Phys. Soc. Jpn. **56**, 11, 4194 (1987).
- [9] Горбунов С.В., Кудяков С.В., Яковлев В.Ю., Кружалов А.В. ФТТ **38**, 1, 000 (1996).

*Физика твердого тела, том 38, № 4, 1996  
Solid State Physics, vol. 38, N 4, 1996*

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МОДУЛЯ ЮНГА В МИКРООБЪЕМЕ МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ

© Ю.И.Головин, А.И.Тюрин

Тамбовский государственный университет,  
392000 Тамбов, Россия  
(Поступило в Редакцию 24 февраля 1995 г.  
В окончательной редакции 11 октября 1995 г.)

В [1] предложено для определения жесткости контактной области при индентировании и эффективного модуля Юнга в микрообъеме в дополнение к постоянно действующей силе прикладывать к индентору небольшую осциллирующую нагрузку и по отклику системы индентор–образец (по зависимости амплитуды колебаний и фазового угла между силой и перемещением от частоты возбуждения) судить о механических свойствах материала в зоне контакта. Для реализации этого способа необходима весьма сложная аппаратура. Однако при достаточно высокой добротности упомянутой системы можно возбудить ее собственные колебания более простым способом — скачкообразным приложением нагрузки к индентору, предварительно аккуратно подведенному к поверхности образца до касания. Быстрое нагружение с непрерывной записью перемещения индентора во времени  $h$  (временное разрешение — 0.3 ms, пространственное — 50 nm) осуществлялось весом грузов, передаваемым через подвижный шток алмазной пирамиды Виккерса, при выключении или скачкообразном уменьшении тока в электромагните, который компенсировал силу тяжести в исходном положении. Измерения показывают, что нагрузка на индентор в этом случае достигала веса подвижных частей через 1–2 ms после переключения тока в электромагните (длительность фронта импульса нагрузки определялась главным образом массой груза и соотношением жесткостей штока и зоны контакта).

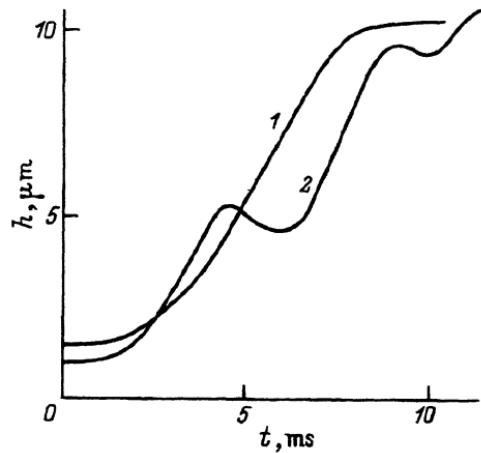


Рис. 1. Кинетика погружения индентора в LiF при  $T = 293$  (1) и  $77$  К (2).

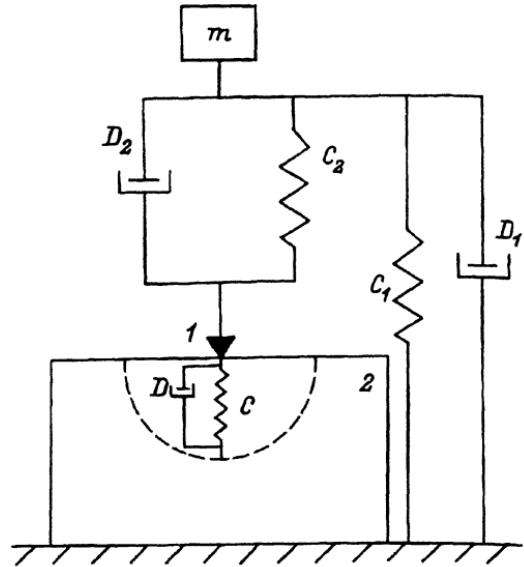


Рис. 2. Расчетная модель осциллирующей системы. 1 — индентор, 2 — образец,  $m$  — масса груза,  $C$  и  $D$ ,  $C_1$  и  $D_1$ ,  $C_2$  и  $D_2$  — жесткости и коэффициенты затухания зоны индентирования, подвески и штоки соответственно.

В жестких кристаллах ( $\text{MgO}$ ,  $\text{Si}$ ) осцилляции при погружении возникали и при комнатной температуре, а в более мягких при охлаждении до  $T \leq 200$  К ( $\text{LiF}$ ) и до  $T \leq 100$  К ( $\text{NaCl}$  и  $\text{KCl}$ ) (рис. 1). Очевидно, амплитуда, частота и декремент затухания колебаний и содержат информацию о механических свойствах материала в контактной области.

Динамическая модель осциллирующей системы (рис. 2) учитывает массу подвижных частей нагружающего устройства  $m$ , жесткость пружин их подвески  $C_1$ , жесткость штока  $C_2$ , жесткость образца в контактной области  $C$  и демпфирующие свойства этих упругих элементов соответствующими коэффициентами затухания  $D_1$ ,  $D_2$  и  $D$ . Наиболее сложным и одновременно существенным параметром здесь является  $C = kE_rA^{1/2}$ , где  $k$  — коэффициент пропорциональности, зависящий от формы индентора,  $E_r = [(1 - \nu^2)E^{-1} + (1 - \nu_i)E_i^{-1}]^{-1}$  — приведенный модуль Юнга,  $E$  и  $\nu$  — модуль Юнга и коэффициент Пуассона материала образца,  $E_i$  и  $\nu_i$  — то же для материала индентора,  $A \approx 13.2h^2$  — площадь проекции отпечатка индентора Виккерса на поверхность образца. Для аксиально-симметричного конуса  $k = 1.13$  по данным [1,2], для трехгранной пирамиды Берковича  $k = 1.17$  [2], а для четырехгранной пирамиды Виккерса  $k = 1.15$  [2]. Другие авторы приводят несколько отличающиеся от этих значения  $k$ , также полученные численным решением трехмерной упругой задачи. Так, например, для пирамиды Берковича в [3] получено значение  $k = 1.69$ . Угловая частота собственных затухающих колебаний  $\omega$  связана с этими параметрами очевидным соотношением  $\omega = \{[(C^{-1} + C_2^{-1})^{-1} + C_1]m^{-1} - D^2\}^{1/2}$ . Конструктивные

особенности установки сознательно приняты такими, чтобы удовлетворялись условия  $C_2 \gg C$ ,  $C_1 \ll C$ ,  $D_1 \ll D$  и  $D_2 \ll D$  (реально  $C_2 = 50 \text{ MN/m}$ ,  $C_1 = 1 \text{ kN/m}$ ,  $D_1 < 1 \text{ s}^{-1}$ ,  $D_2 < 0.1 \text{ s}^{-1}$ ,  $D \geq 30 \text{ s}^{-1}$ , а измеренные значения  $C$  составляли 3–5  $\text{MN/m}$ ), так что в первом приближении режим погружения и возникающих колебаний определялся только свойствами материала в контактной области, т.е. величинами  $C$  и  $D$ . Поскольку  $C$  растет пропорционально  $h$ , при некотором критическом значении  $h_c$  начинает выполняться условие  $Cm^{-1} \geq D^2$ , и система из апериодического режима переходит в колебательный. В исследованных кристаллах при нагрузке в несколько  $N$  он наступал при  $h_c = 3\text{--}14 \mu\text{m}$ .

Сопоставление результатов эксперимента и табличных значений модуля Юнга исследуемых материалов

Номер опыта	Тип кристалла	$T, \text{ K}$	Нагрузка на индентор $F, \text{ H}$	Модуль Юнга			Наличие трещин	
				$E_c, \text{ GPa}$ (справочное значение)	$E_s, \text{ GPa}$ (расчет при $k$ )			
					1.13	1.69		
1	NaCl	77	12.7	49	50	33	Отсутствуют	
2	LiF	77	1.9	114	125	82	То же	
3	LiF	77	9.0	114	66	44	Единичные	
4	KCl:Ba (0.1 mol%)	77	4.6	40	22	14	То же	
5	MgO	273	5.7	286	41	27	Множественные	

Как видно из таблицы, определенные таким образом значения модуля Юнга исследуемого материала  $E_c$  в случае отсутствия разрушений под индентором совпадают со справочными значениями  $E_s$ , с точностью лучше 10% (при  $k = 1.13$  [1,2]). При этом совпадение расчетных и справочных данных для кристаллов LiF и NaCl не может быть случайным, несмотря на то что величина  $E_c$  является эффективной (так как отражает упругие свойства материала сильно и неоднородно деформированной области контакта). Для значений  $k = 1.69$  [3] такого согласия не наблюдалось ни в одном из опытов. В тех случаях, когда индентирование сопровождается трещинообразованием,  $E_c > E_s$ , что вполне естественно, так как к податливости сжатия кристаллической решетки добавляется податливость, связанная с образованием и раскрытием трещин.

Таким образом, измерение параметров собственных колебаний системы индентор–образец в материалах, не склонных к хрупкому разрушению, может быть использовано для определения модуля Юнга в объемах  $\sim 10^2\text{--}10^3 \mu\text{m}^3$ , а в хрупких материалах — для обнаружения трещин под индентором по дефекту модуля. Кроме того, эта методика позволяет осуществлять обоснованный выбор между различными моделями упругого поведения материала под индентором, как это видно из приведенной таблицы.

## Список литературы

- [1] Oliver W.C., Pharr G.M. J. Mater. Res. **7**, 6, 1564 (1992).
- [2] Pharr G.M., Oliver W.C., Brotzen F.R. J. Mater. Res. **7**, 3, 613 (1992).
- [3] Murakami Yu., Tanaka K., Itokazu M., Shimamoto A. Phil. Mag. **A69**, 6, 1131 (1994).

Физика твердого тела, том 38, № 4, 1996  
Solid State Physics, vol. 38, N 4, 1996

# ТЕМПЕРАТУРА СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПЕРЕХОДА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЩЕЛЬ В СВЕРХПРОВОДНИКАХ $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ ПРИ $0.41 \leq x \leq 0.88$

© Е.И.Никулин, Ю.П.Степанов

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук,  
194021 Санкт-Петербург, Россия  
(Поступило в Редакцию 11 октября 1995 г.)

Важнейшими характеристиками сверхпроводника являются температура сверхпроводящего перехода  $T_c$  и величина энергетической щели  $\Delta$ . В настоящей работе приведены результаты измерения  $T_c$  и  $\Delta$  образцов  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$  в широкой области изменения содержания кислорода  $x$  до исчезновения сверхпроводимости.

Была приготовлена серия керамических образцов  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$  от  $x = 0.88$  до  $x = 0.41$ . Исходный материал получали золь-гельным методом из особо чистых нитратов иттрия, бария и меди. Вариации концентрации кислорода в образцах достигались термической обработкой в вакууме. Содержание кислорода в образцах  $x$  определялось иодометрическим методом с точностью 0.01. Для обеспечения однородности образцы отжигались при температуре 550°C в течение 5 h и затем охлаждались со скоростью 10 градусов в час. Образцы представляли собой прямоугольные бруски размером  $2 \times 2 \times 10$  mm. Измерение проводимости  $\sigma$  и температуры перехода  $T_c$  производилось на постоянном токе четырехконтактным методом.

Переход был резким при больших содержаниях кислорода и становился заметно размытым при меньших  $x$  (например, при  $x = 0.50$  переход растягивался на 10 градусов). Как обычно,  $T_c$  соответствует уменьшению сопротивления образца вдвое.

Для определения значения энергетической щели была разработана методика, связанная с измерением дополнительного сопротивления на границе нормальный металл–ВТСП (NS-границе) [1]. Массивный медный электрод был плотно прижат к полированной поверхности бруска  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ , образуя туннельный контакт, где роль изолирующего слоя (и NS-границы) играет воздушный зазор и (или) слой окисла на поверхности ВТСП. Сопротивление такой ячейки включает последовательно соединенные сопротивления массивного медного электрода, туннельного контакта и образца ВТСП. Все измерения проводились при гелиевых температурах. При 4.2 K сопротивление медного электрода близко к нулю, сопротивление образца ВТСП равно нулю и сопротивление ячейки определяет туннельный контакт. При пропускании тока падение напряжения на туннельном NS-контакте  $V$